



CAS IR Grid / 上海技术物理研究所 / 中国科学院上海技术物理研究所 / 上海技物所

新型高K栅介质双沟道Ga_N基MOS-HEMT器件的栅极介质沉积工艺与电流坍塌效应的研究

文献类型: 成果

作者 胡伟达

获奖日期 2010

文献子类 AM基金

学科主题 红外基础研究

语种 中文

源URL [http://202.127.1.142/handle/181331/1345]

专题 上海技术物理研究所_上海技物所

推荐引用方式 胡伟达. 新型高K栅介质双沟道Ga_N基MOS-HEMT器件的栅极介质沉积工艺与电流坍塌效应的研究. . 2010.
GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [上海技术物理研究所](#)

浏览

16

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。